

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形トランジスタ

2SD359, 2SD360

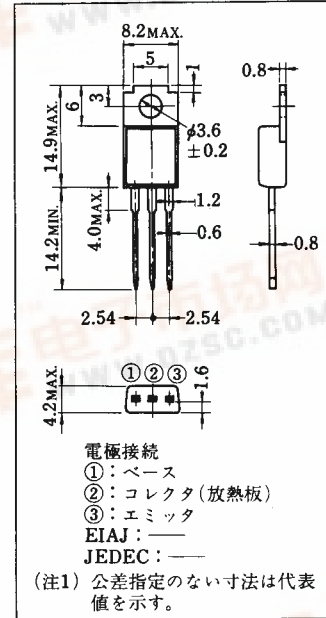
低周波電力増幅用 (3~4W出力用—2SD360)
(4~5W出力用—2SD359)

- 大電流で h_{FE} の低下が少ない。
- knee 特性が良い ($V_{CE} \leq 1V$ —2SD359, $V_{CE} \leq 2V$ —2SD360)。
- モールドパワートランジスタで、小形かつ取付けが容易です。
- 2SB529, 2SB523 とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

最大定格 (周囲温度 25°C)

項 目	記 号	定 格 値	単 位	
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	40	V	
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V	
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	20	V	
コレクタ電流	I_C	2	A	
せん頭コレクタ電流	I_{CM}	3	A	
コレクタ損失	$T_a = 25^\circ C$	P_C	1	W
	$T_c = 25^\circ C$	P_C	10	W
接合部温度	T_j	+150	°C	
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C	

外形図 単位: mm



電気的特性 (周囲温度 25°C)

項 目	記 号	測 定 条 件	2SD359			2SD360			単 位
			最小	標準	最大	最小	標準	最大	
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = 1mA, I_E = 0$	40	—	—	40	—	—	V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 1mA, I_C = 0$	5	—	—	5	—	—	V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10mA, R_{BE} = \infty$	20	—	—	20	—	—	V
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 25V, I_E = 0$	—	—	1	—	—	1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	—	—	1	—	—	1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 4V, I_C = 0.5A, \text{パルステスト}$	55	110	300	55	110	300	—
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE}	$I_C = 1.5A, I_B = 0.05A$	—	—	1	—	—	2	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 4V, I_C = 0.05A$	—	0.7	—	—	0.7	—	V

h_{FE} の値により下表のようにアイテム分類を行なっています。

アイテム	C	D	E
h_{FE}	55~110	90~180	150~300